

I transistori a effetto di campo (field effect transistor, FET) al nitruro di gallio (gallium nitride, GaN) ad alta tensione di Transphorm potenziano l'alimentazione di corrente ad alta frequenza di livello militare dei dispositivi di Marotta Controls

La frequenza di commutazione e il rendimento d'alimentazione dei dispositivi al nitruro di gallio (gallium nitride, GaN) sono superiori a quelli dei dispositivi in silicio per la creazione di un design con raffreddamento per conduzione

GOLETA, California--(BUSINESS WIRE)-- [Transphorm Inc.](#) - leader nella progettazione e nella produzione di semiconduttori annoverati tra i più affidabili, nonché dei primi semiconduttori al nitruro di gallio (GaN) conformi agli standard JEDEC e AEC-Q101 - ha annunciato oggi, insieme a [Marotta Controls](#), che l'unità di alimentazione (power supply unit, PSU) che verrà lanciata prossimamente dal fornitore dei settori Aerospaziale e della Difesa sostituirà gli attuali transistori a effetto di campo metallo-ossido-semiconduttore (metal-oxide-semiconductor field-effect transistor, MOSFET) al silicio (silicon, Si) con dispositivi PQFN (quad flat no-leads) GaN per l'offerta di vantaggi avanzati.

L'ultimissimo design di Marotta opera ad alta frequenza entro un involucro meccanicamente contenuto con raffreddamento per conduzione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti per la stampa:

Heather Ailara

211 Communications

heather@211comms.com

+1.617.283.9222

Katee Glass

Marotta Controls

kglass@marotta.com

+1.973.316.4256

Source: Transphorm Inc.

